

平成 30 年 4 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山村 章
(JASDAQ・コード6890)
問合せ先 取締役経営企画担当 若木 啓男
(03-3281-8186)

当社子会社における新会社設立並びに新工場着工に関するお知らせ

当社は、昨年 12 月に当社子会社の上海申和熱磁電子有限公司の 100%連結子会社として、半導体製造装置、FPD 製造装置の部品の精密再生洗浄工場の中国における新規開設を目的に、中華人民共和国安徽省銅陵市に新会社（安徽富樂徳科技發展有限公司）を設立し、平成 30 年 3 月 28 日に新工場の着工式を執り行いましたのでお知らせいたします。

1. 目的と狙い

当社は 2001 年に中国上海において、半導体製造装置、FPD 製造装置の部品の精密再生洗浄事業に参入して以来、天津、四川、大連へと順調に拠点を拡大して参りました。また、最近『中国製造 2025[®]』に伴う中国政府による中国国内の半導体メーカー育成・強化の中で、微細化、3D 化等の先端投資に応じて半導体製造装置の部品の洗浄頻度と要求精度が上昇しており、大手半導体デバイスメーカー及び FPD パネルメーカー並びに同製造装置メーカー各社から当社に対し、洗浄工場の新規拠点の開設要請が来ておりました。

当社としては、顧客との関係強化と洗浄事業の更なる拡大を図れる好機と捉え、近年半導体や FPD パネルメーカーの進出が著しい安徽省に 5 拠点目の洗浄工場を開設することとしました。今回の工場新設により、当社は当該事業の中国における更なる市場シェアの拡大と収益力を向上させることが可能になるとともに、中国における精密再生洗浄業界の No.1 サービスプロバイダーとしての地位をさらに強固なものにすることが期待されます。

尚、当社グループとしては、引き続き本精密再生洗浄事業を通して主力セグメントである装置関連事業の半導体製造装置部品（真空部品・マテリアル製品）の拡販に繋げて行きながら、同事業の比重をさらに上げていく所存です。

注) 中国政府（国務院）が、「製造強国」を目指すべく、2015 年 5 月 19 日に発表した将来における製造業発展のロードマップであり、2025 年に向けて中国の製造力を世界トップ水準に引き上げる発展方針が打ち出されております。その中には、製造業のイノベーション能力の向上や情報化と工業化の高度な融合の推進をはじめとする九つの戦略任務と、次世代情報技術、高度なデジタル制御の工作機械とロボット、航空・宇宙設備などからなる十の重点分野が盛り込まれており、半導体については、先端 IC とコア製造装置の国産化が主な方針として打ち出されています。

2. 設立した会社の概要

(1)	名 称	安徽富楽徳科技発展有限公司
(2)	所 在 地	中国安徽省銅陵市金橋経済開発区内
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢
(4)	事 業 内 容	半導体・液晶向け高純度プロセスツールパーツ洗浄サービス
(5)	資 本 金	5,000 万人民币元
(6)	設 立 年 月 日	2017 年 12 月 26 日
(7)	大株主及び持ち株比率	上海申和熱磁電子有限公司（当社連結子会社）100%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係 当社が100%出資している上海申和熱磁電子有限公司が100%出資の孫会社となります。
		人 的 関 係 該当事項はありません
		取 引 関 係 記載すべき取引関係はありません。

3. 新工場の概要

(1)	所 在 地	中国安徽省銅陵市金橋経済開発区内
(2)	敷 地 面 積	約 36,663 m ²
(3)	進出地域、優遇措置	<p><進出地域></p> <p>銅陵市金橋経済開発区は上海から西へ約350kmの上海と武漢の中間地に位置し、また、南京からは約160km、合肥からも約180kmと、長江デルタエリアを全てカバーできる位置にあります。また、交通アクセスとしては、上海から新幹線で約3時間半と日帰り圏内にあります。</p> <p><優遇措置></p> <p>主に、土地購入・装置購入・税金に関して、補助金及び還付等の優遇措置が受けられます。</p>
(4)	投 資 形 態	土地、建物、設備とも自己投資による。
(5)	生 産 品 目	PVD, CVD, ETCH 等 ^⑥ で使用する半導体・液晶製造装置部品高精密再生洗浄
(6)	投 資 金 額	約 5,000 万元（設備投資及び運転資金を含む）
(7)	資 金 調 達 方 法	自己資金
(8)	稼働開始日	2018 年 12 月頃

4. 今後の見通し

当社の平成 31 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

注) PVD (Physical Vapor Deposition): 物理的気相成長と言われる半導体製造プロセスの一つで、真空中で金属の原子や分子を物質の表面に高速でぶつけることでウェハに膜を堆積させる方法。

CVD (Chemical Vapor Deposition): 化学的気相成長と言われる半導体製造プロセスの一つで、物質表面あるいは気相での化学反応によりウェハの表面に膜を堆積させる方法。

ETCH: 半導体製造プロセスの一つで、ウェハ上に酸化膜等の薄膜を形成し、フォトリジストを塗布してパターン露光後に不要な薄膜を除去する方法。

【着工式の様子】

